Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт з виконання лабораторної роботи №3 з дисципліни "Аналогова електроніка - 1"

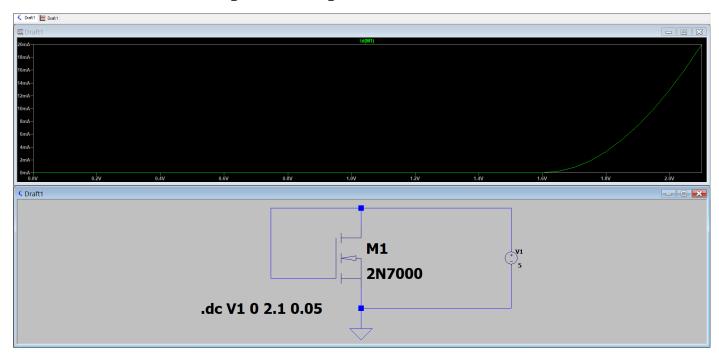
Виконав: студент групи ДК-82

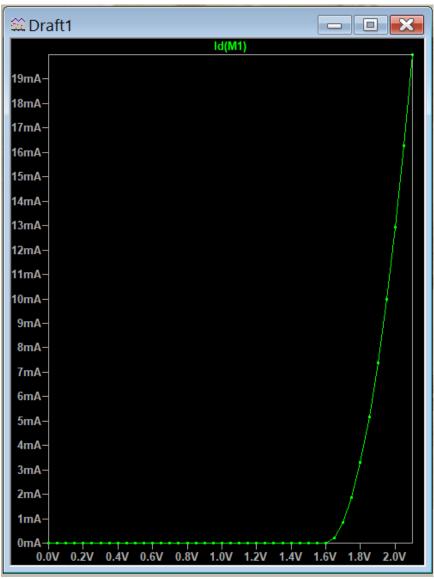
Рудюк Б. Б.

Перевірив: доц.

Короткий Є. В.

1. Дослідження залежності Іс (Uзв) для п-канального польового МДН транзистора 2N7000.





Симуляція в LTspice.

Далі з цього графіку необхідно визначити величину порогової напруги транзистора і за допомогою цих данних обрахувати константу b з формули:

$$Ic = \frac{b}{2} \cdot (U_{3B} - U_{\Pi})^2$$
.

1) Вибраємо значення струму Іс1 = 4mA, використовуючи графік залежності Іс від напруги V1, знаходимо значення напруги Uзв1:

$$U_{3B1} = 1,816 \text{ V}.$$

2) Вибираємо значення струму Ic2, яке в 4 рази більше ніж Ic1 => Ic2 = 4*Ic1 = 16mA Напруги при цьому срумі :

$$U_{3B}2 = 2,045 \text{ V}.$$

3) Використовуючи формулу Ic = $\frac{b}{2}$ ·(Uзв - Uп)^2, запишемо її для двох випадків:

$$Ic1 = \frac{b}{2} \cdot (U3B1 - U\Pi)^2$$
; $Ic2 = \frac{b}{2} \cdot (U3B2 - U\Pi)^2$.

Замість Іс2 підставляємо 4*Іс1 і ділимо вираз один на одного і маємо:

$$U_{\Pi} = 2*U_{3B}1 - U_{3B}2$$

3 цього виразу знаходимо значення порогової напруги:

$$U\pi = 2*1,816 - 2,045 = 1,587 \text{ V}.$$

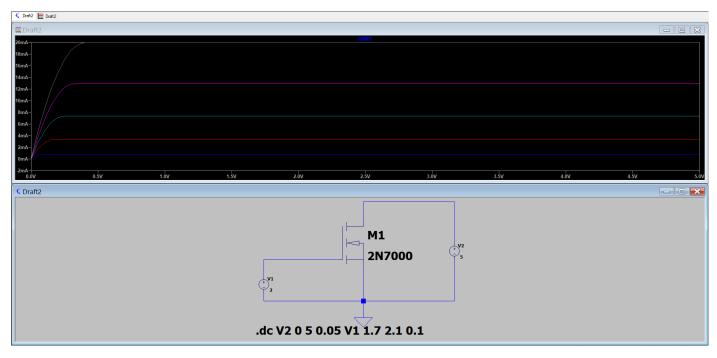
4) За домогою отриманого значення Uп, можемо знайти в використовуючи наслідок з формули з пункту (3):

$$b = \frac{2*Ic1}{(U3B1-U\Pi)^2}$$

Звідси маємо:

$$b = \frac{2*4*10^{-3}}{(1,816-1,587)^2} = 0,153$$

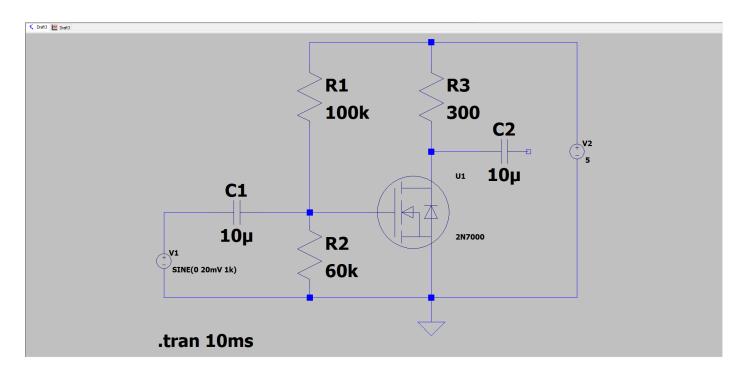
2. Дослідження залежності Іс (Uвс) для n-канального польового МДН транзистора 2N7000.





Симуляція в LTspice.

3. Дослідження підсилювача з загальним витоком на польовому МДН транзисторі 2N7000.



Симуляція в LTspice.

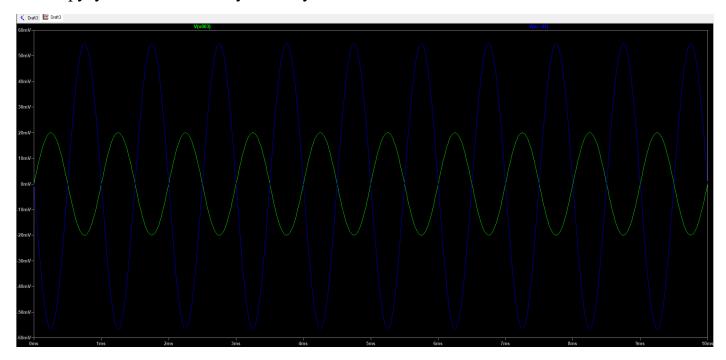
1) Виставляємо напругу генератора V1 рівну 0 В і вимірюємо напругу між витоком і затвором Uзв0 (напруга на резисторі R2), між витоком і стоком Uвс0 і струм стоку Ic0:

Uзв0 = 1,875 V.

UBc0 = 3,289 V.

Ic0 = 5,706 mA.

2) Виставляємо на генераторі Г3-112 (джерело V1) гармонічну синусоїдальну напругу вхідного сигналу амплітудою 20 mV та частотою 1 kHz.



Як видно з симуляції схема зсуває фазу сигналу на 180 градусів.

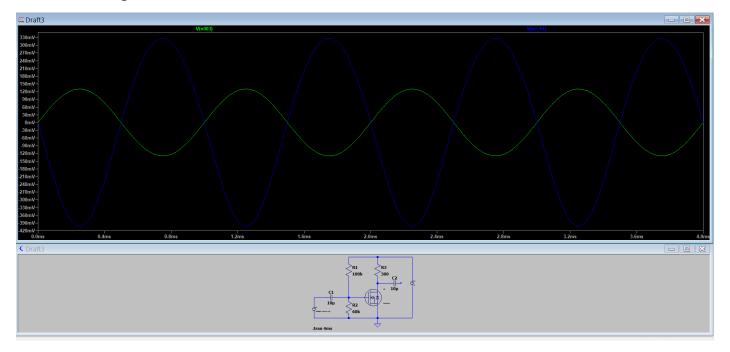
Знаходимо коефіцієнт підсилення за напругою, як відношення амплітуди гармонічного сигналу на виході до амплітуди гармонічного сигналу на вході:

$$U$$
вих = -54,8 mV; U вх = 20 mV

$$Ku = Uвих / Uвх = -54,8 / 20 = -2.74$$

3) Для знаходження максимальної амплітуди вхідного сигналу напругу на вході підвищували до тих пір, поки на виході не з'явились нелінійні спотворення. Такою напругою виявилась 80÷120 mV.

Спотворення виглядали так:



4) Для експериментального визначення передавальної провідності, робочу точку транзистора змістили на 0,114В шляхом збільшення резистору R2 на 5kOm. Струм спокою виріс до 6,87 mA.

Тоді
$$\Delta U_{3B} = 0,114 \text{ V}$$
, а $\Delta I_{C} = 1,164 \text{ mA}$.

Передавальну провідність обраховуємо за формулою:

gm=
$$\frac{\Delta Ic}{\Delta U_{3B}}$$

$$gm = \frac{1,164*10^{-3}}{0.114} = 0,011 = 11 \text{ ms.}$$

5) Обрахуємо теоретичний коефіцієнт підсилення за напругою даної схеми за формулою:

$$Ku = -Rc \cdot gm$$

$$Ku = -11 * 10^{-3} * 300 = -3.3$$

Як бачимо коефіцієнт підсилення, який ми визначили експерементально не сильно відрізняється від обрахованого.